This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

刑行物(百)

(B)20300910272

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開番号

特開平9-69554

(43)公開日 平成9年(1997)3月11日

. (51) IntCL*	識別記号 广内整理番号	FI	技術表示箇所
H01L 21/68		H01L 21/68	R c
B 2 3 Q 3/15		B 2 3 Q 3/15	D
C01G 23/04		C01G 23/04	Z
C23C 4/10	•.	C 2 3 C 4/10	•
H01L 21/205		H 0 1 L 21/205	
	書空游求	未請求 請求項の数10 OI	(全10頁) 最終頁に続く
(21) 出願番号	特原平7 -223149	(71)出題人 000109875	
		トーカロ株式	式会社
(22)出頭日	平成7年(1995) 8月31日	兵庫原神戸1	市東羅区際江北町 4丁目13番4
		号	
		(72)発明者 原田 良夫	
		兵庫県明石市	市大久保町高丘1丁目8番18号
		(72) 発明者 竹内 純一	,
		兵庫県神戸1	市東灘区本庄町2丁目5番12号
	•	-705	
		(74)代理人 弁理士 小/	川 麗三 (外1名)
•		·	
			•
	'	,	
		1	

(54) 【発明の名称】 静電チャック部材およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 体接関有抵抗が小さくかつ吸着力が小さいこと、および表面平滑性が悪いと共に、基板との密着性が悪く、また生産性が低いこと。

【解決手段】 金属基板上に、金属質溶射被覆のアンダーコートを有し、かつその上にTia Oza-i 型化合物を含有するAlz-Oz ・TiOz系セラミック溶射被覆を有する静度チャック部材、および、上配セラミック溶射材料を、30~750 hpa の圧力に調整されたArガスもしくは空気雰囲気中で、水素ガスを含むブラズマ溶射法によって、前記溶射材料中のTiOzのすべてまたはその一部をTia Oza-iで表される結晶型化合物に変化させる静電チャック部材の製造方法。

特開平9-69554

【特許請求の範囲】

【請求項1】 金鳳基板上に、金属質溶射被磁のアンダーコートを有し、かつその上にはTim On-1 (n=1~9)型 化合物を含有する AliO:・「TiO:系セラミック溶射被覆を 有することを特徴とする静電チャック部材。

【請求項2】 金属質溶射被覆の厚さが30~150 μm、 Tia On-1 (n=1~9)型化合物を含有する Al2O・TiO2系 セラミック溶射被覆の厚さが50~500 μmである、調求 項1に記載の静電チャック部材。

【請求項3】 上記Tia Oze.1 (n=1~9)型化合物を含有する Λl:0,・TiO:系セラミック溶射被覆は、気孔率が0.4~3.0 %で、表面相さRaが0.1~2.0 μ mの範囲内のものである、請求項1に記載の登電チャック部材。

[請求項4] 上記Tia Cra. (n=1~9)型化合物を含有する Al203・TiO2系セラミック溶射被援は、その表面に、有機系もしくは無機系理素化合物の封孔処理層を有し、かつは傾固有抵抗値が1×10°~1×10¹¹ Q・cmの 欽明にある、請求項1に記載の静電チャック部材。

【請求項5】 上記金属質溶射板摂は、Ñ1, A1, Gr, Co, Co, Moおよびこれらの金属元素を1種以上含む合金のうちから選ばれるいずれか1種以上を素材とする層である、請求項1または2に記載の静電チャック部材。

[請求項6] 上記 AlzOs・TiOz系セラミック溶射被覆は、この被覆中に含まれるTis Oza-1 (n=1~9)で表される結晶型化合物が、TizOs, TizOs, TiO , TixOr, TisOs, TicOn, TixOr, TisOs, TizOr, TixOr, TixOr,

【請求項7】 金属基板をブラスト処理した後その表面に、金属質溶射被優であるアンダーコートを形成し、さらにその上に、TiOsを2~30wt%を含む AliOi・TiOs系でラミック溶射材料を、30~750 hPa。の圧力に調整されたArガスもしくは空気雰囲気中で、水素ガスを含むプラズマ溶射法によって、前配溶射材料中のTiOsのすべてまたはその一部をTiz。Ozn-1 (n=1~9)で表される結晶型化合物に変化させたトップコート溶射被覆を形成することを特徴とする静電チャック部材の製造方法。

【請求項8】 金属基板をプラスト処理した後その表面に、アンダーコートとして金属質溶射被覆を形成し、さらにその上にトップコートとして、TiO:を2~30mt%を含む AlzO:・TiO:溶射材料を、30~750 hPa の圧力に調整されたArガスもしくは空気雰囲気中で、木素ガスを含むプラズマ溶射法によって、前配溶射材料中のTiO:のすべてまたはその一部をTia Ohni (n=1~9)で表される結晶型化合物に変化させたセラミック溶射被覆を形成し、その後、セラミック溶射被覆の表面組さを&a O.1~2.0μmに研磨仕上げすることを特徴とする静電チャック部材の関連方法。

【請求項9】 全属基板をブラスト処理した後その表面 に、アンダーコートとして金属質溶射被優を形成し、さ 50 らにその上にトップコートとして、TiOs を2~30xt%を含む AlzOs・TiOs溶射材料を、30~750 NPaの圧力に調整されたArガスもしくは空気雰囲気中で、水素ガスを含むプラズマ溶射法によって、前記溶射材料中のTiOsのすべてまたはその一部をTia Ozz-1 (n=1~9)で表される結晶型化合物に変化させたセラミック溶射被限を形成し、その後、セラミック溶射被限の表面視さをRaO.1~2.0μmに研磨仕上げし、次いでその研磨仕上げ面を建築化合物によって封孔処理することを特徴とする静電チャック部材の製造方法。

【請求項10】 上記封孔処理は、セラミック溶射核覆の表面に有機系もしくは無機系の珪素化合物を盤布したのち、120~350 ℃で1~5時間加熱することによって行うことを特徴とする請求項9に記載の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本苑明は、厚重性部材、半導 電性部材、絶縁性部材を静電気によって吸着保持すると きに用いられる静電チャック部材に関するものであり、 とくに、半薄体や液晶の製造プロセスにおいて使用され るドライエッチング装置、イオン社入装置、CVD装置 あるいはPVD装置などに組み込まれて用いられるもの である。

[0002]

【従来の技術】最近、半等体や液晶の製造プロセス、例えば半導体製造変置では、それの一部を構成しているドライエッチング、イオン注入、CVD、PVDなどの処理が、自動化ならびに公害防止の立場から、湿式注から乾式法による処理へと変化している。その乾式法による処理の大部分は、真空雰囲気下で行われるのが普通である。

【0003】こうした乾式処理において重要なことは、例えば、基板として用いられているシリコンウェハーやガラス板などについては、最近、回路の商集積化や被細加工化の観点から、パターニング時の位置決め精度を向上させることにある。こうした契請に応えるために従来、基板の搬送や吸着固定に際して、真空チャックや機被チャックを採用していた。しかしながら、真空チャックは、真空下での処理になることから、圧力差が小さいため吸着効果が少なく、たとえ吸着できたとしても吸着部分が局部的となるため、基板に歪が生ごるという欠点があった。その上、ウエハー処理の高温化に伴うガス冷却ができないため、最近の高性能半導体製造プロセスに適用できないという不便があった。一方、機械チャックの場合、装置が複雑となるうえ、保守点横に時間を要するなどの欠点があった。

【0004】このような従来技術の欠点を衝うため 近、静電気力を利用した静電チャックが開発され、広く 採用されている。しかし、この技術も、次のような問題 点が指摘されている。それは、かかる静電チャックによ って基板を吸着保持した場合、印加電圧を切ったのち も、基板と静電チャックとの間に電荷が残留(吸着力が 働き)するので、完全に除電した役でなければ基板の取 外しができないという問題があった。

[0005] その対策として、従来、該静電チャックに 使用する絶縁性誘致体材質を改良することが試みられて いる。例えば、

- ① 特開平6-8089号公報…高絶線物として壺化アルミ 粉末と童化チタン粉末の混合物の焼結体またはその溶射 皮膜を用いる。
- ② 特開平 6 -302677号公報…高絶縁物に酸化チタンを 被覆した後、その上にアルミを被覆し、Si+SiCブンートを接触させる。
- ③ 特公平6-36583 号公報…高純額件(酸化アルミニウム)を使用する。
- 特開平4-304942号公報,特開平5-235152号公報,特開平6-8089号公報…酸化アルミニウム,変化アルミニウム、酸化亜鉛、石莢、窒化硼素、サイアロンなどを使用する。
- ⑤ そして、さらに大きな静電力を必要とする場合、高 20 能縁体に誘電率の高いTiO: (チタニア)を添加して体積 固有抵抗値を下げて静電力を向上させる方法が、特開昭 62-94953 号公報、特開平 2-206147号公報、特開平 3 -147842号公報、特開平 3-204924号公報などで提案されている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】この発明は、以下に列 学するような、従来の AlzOs・TiOs系 (アルミナーチタ ニア系) 容射被覆が有する欠点を解決課題とするもので ある。

(1) 静電吸着機能を持つ溶射被覆として、TiOzを混合し たAl:O1 を用いるものに、体積固有抵抗が小さく、微少 電流が流れるため、ジョンセン・ラーベック効果によっ て静蔵力の向上が期待できる。しかしながら、そのTiO: (チタニア) は半導体物質であることから、電荷の移動 速度が遅く、電圧の印加を止めたときの応答特性(飽和 吸着力到達時間, 吸着力消滅時間) が劣る。この特性 は、低温環境では一層顕著となる。さらに、体積固有抵 抗値を、例えば実用状態の1×10°Ω・cmにするために は、チタニアを25重量%程度混合する必要があるが、半 40 連体製造プロセスにおいては、チタニアの大量流入は不 純物の混在を意味することになり、品質の低下を招くと 共に、作業環境を汚染する原因となる。その上、吸着す る半尊体ウェハーが室温以上の場合には、体積固有抵抗 が低すぎるため、大きなリーク電流が流れてウェハー回 路が破壊される可能性が高い。

【0007】(2) Al20: TiO:系溶射被覆は、溶射法によって施工されるが、この方法で得られる該被限は、体 種固有抵抗および吸着力のパラツキが大きく、生産性が 低いため、コストアップの原因となっている。 【0008】(3) AL:0・Ti0:系溶射被覆は、多孔質であることから、高度な表面仕上げができないだけでなく、異物が付着残留することが多い。また、基板との密管性が低いために、使用環境下、特に熱変化時に基板と被覆が剥離するという問題点があった。

【0009】この発明の主たる目的は、体質固有抵抗が大きくかつそのバラツキも小さく、品質の安定した静蔵チャック部材を提供することにある。この発明の他の目的は、吸着力が強く、一方で電圧の印加を止めたときの応答性能(リリース特性)に優れた静電チャック部材を提供することにある。この発明の他の目的は、基板との密着性に優れる他、厳密で表面平滑性にも優れる静電チャック部材を提供することにある。また、この発明のさらに他の目的は、上掲の特性を有する静電チャック部材を高い生産性の下に有利に製造する技術を確立することにある。

[00.10]

【課題を解決するための手段】本発明は、上述のような 課題を抱えている静電チャック部材、とくに基板とに形 成する Al:O:・TiO:系容射被覆を有する部材につき鋭意 検討した結果なされたものであって、以下に示す知見に 基づくものである。

- ① 発明者らの研究によると、従来の AlzOs TiOs 系容 射被覆が抱えている問題点に、その原因が主として、Ti Os (チタニア) にあることを実験によって確認した。そ して、このTiOs をTia Osas (n=1~9)に結晶型を変化さ せれば、その原因は克服できることを発見した。
- ② そして、このようなTi_n O₂₋₁ (n=1~9)を含む Al₂ O₃・TiO3系溶射被覆を確実に得る手段としては、以下のような方法が有効であるとの知見を得た。
- a. 酸素分圧の低い素簡気下で、AlzO・TiO:材料を溶射することによって、TiO:から酸素を遊離させてTia O
 m-1 (n=!~9)に変化させる方法。このように、TiO2をT
 ia Om-1 (n=1~9)へ変化させることによって、従来技術で問題となっていた広客特性が改善され、また、体積低抗値のパラツキが小さくなり、品質および生産性が向上するようになる。
- b. Tia Oia-1 (n=1~9)を含む溶射被費は、実質的に酸 来を含まない雰囲気や大気圧より低い圧力に制御できる 空気雰囲気中において、水素を含むプラズマを熱源として溶射することによって得られる。この点、大気圧より 低い圧力下で溶射すると、熱源中を飛行する溶射粒子 は、気体による抵抗が小さいため、基板への衝突力が強 くなり、酸密で密着力のよい被覆が形成される。なお、 このような緻密な溶射被覆は、高度な表面仕上げが可能 となるほか、体積抵抗値のバラツキを小さくする効果が ある。
- c. さらに溶射熱源としてのプラズマに、還元作用の強い水素ガスを用いることによって、TiO: からTis Ora-1 (n=1~9)の変化が速やかに進行し、前記 a. bの作用線

榜を──層効果的に促進することができるようになる。

[0011] 本発明は、上述した知見に基づいて開発したものであり、以下にその要旨構成を示す。

- (i) 金属基板上に、金属質溶射被覆のアンダーコートを 有し、かつ、その上にTi。 01e-1 (n=1~9)型化合物を含 有する Al20s・Ti02系セラミック溶射被覆を有すること を特徴とする静電チャック部材。
- (2) 上記辞電チャック部材は、金属資溶射被限の厚さが 30~150 μmで、Tio Ota (n=1~9)型化合物を含有する Alion - Tion系セラミック溶射被機の厚さが50~500 μmである。
- (3) 上記辞電チャック部材は、Ti. Crn.1 (n=1~9)型化合物を含有する AlaOs・TiOz系セラミック溶射破覆の気孔率が、0.4 ~~3.0 %で、表面祖さRaが 0.1~2.0 μmの範囲内のものである。
- (4) 上記「in Ozn-1 (n=1~9)型化合物を含有する ALO · TiO: 系セラミック溶射接種は、その表面に、有機系もしくは無機系建業化合物の封孔処理層を有し、かつ体積固有抵抗の値が 1×109 ~ 1×10¹¹ Ω·cmの範囲にあ
- (5) 上記金属質アンダーコート溶射被覆は、11, A1, C r. Co. Noおよびこれらの金属元素を1種以上含む合金 のうちから選ばれるいずれか1種以上を来材とする層で ある。
- (6) 上記 AlzO: ・TiO:系セラミック溶射被優は、この被 後中に含まれるTis Oss 1 (n=1~9)型で表される結晶型 化合物が、TisOs, TizOs, TiO. TisOs, TisOs, TisOs, TisOs, TirOs, TizOs のうちから選ばれるいずれか 1種以上の化合物である。

【0012】上記録起チャック部材は、下記の各方法の 採用によって製造することができる。

- (7) 金属基板をプラスト処理した後その表面に、金属質溶射被覆であるアンダーコートを形成し、さらにその上に、TiOzを2~30~t%を含む AlzOi・TiOz系セラミック溶射材料を、30~750 hPa の圧力に調整されたルガスもしくは空気雰囲気中で、水素ガスを含むプラズマ溶射法によって、前配溶射材料中のTiOzのすべてまたはその一部をTin Ozoi (n=1~9)で表される結晶型化合物に変化させたトップコート溶射被覆を形成することを特徴とする静成チャック部材の製造方法。
- (8) 金属基板をプラスト処理した核その表面に、金属質溶射被優であるアンダーコートを形成し、さらにその上にトップコートとして、TiOzを2~30wt%を含む Al; Os・TiOz 格別材料を、30~750 hPa の圧力に調整されたAr ガスもしくは空気雰囲気中で、水素ガスを含むプラズマ溶射法によって、前配溶射材料中のTiOz のすべてまたはその一部をTio Ozo-1 (n=1~9)で表される結晶型化合物に変化させたセラミック溶射被優を形成し、その後、セラミック溶射被優の表面組さをNa O.1~2.0 μmに研磨仕上げすることを特徴とする静電チャック部材の製造方 50

法

- (9) 金属基板をプラスト処理した後その表面に、金属質アンダーコート溶射被覆を形成し、さらにその上に、Ti Ot を2~30xt%を含む Alan ・TiOt溶射材料を、30~75 O hPa の圧力に調整されたなガスもしくは空気雰囲気中で、水素ガスを含むプラズマ溶射法によって、前配溶射材料中のTiOtのすべてまたはその一部をTia Onat (n=1~9)で表される結晶型化合物に変化させたセラミック溶射被覆を形成し、その後、セラミック溶射被覆の表面相さをPa O.1~2.0 μmに研磨仕上げし、次いでその研磨仕上げ面を建業化合物によって對孔処理することを特徴とする静電チャック部材の製造方法。
- (10) なお、上記封孔処理は、セラミック溶射被硬の表面に有機系もしくは無機系の建素化合物を塗布したのち、120~350 ℃で1~5時間加熱することによって行うことを特徴とする。

[0013]

【発明の実施の形態】本発明の特徴は、基板上に形成する AlrOs・TiOs 系容射被覆の成分を、Tio Oses (n=1~9)で表される結晶型化合物を含むものにした点の構成にある。以下に、本発明にかかる静電チャック部材のかかる構成につき、 AlrOs・TiOs 溶射被覆を作契する方法とその作用機構の説明にあわせ、製造工趣順に述べる。

【0014】(1) 金属基板上へのアンダーコートの施工本発明にかかる静電チャック部材は、Al, No, Wおよび Cなどを基板とし、先ずその金属基板の表面に、Al:05粒子(#40)を吹付けて、均一に粗面化するとともに清 冷化する。次いで、その上に、Fi Al, Cr. Co, No などの金属またはこれら金属の合金を溶射材料として、アーク溶射性もしくはプラズマ溶射性によって、厚さ30~150μmのアンダーコートとしての金属質溶射被優と施工する。この金属質溶射被優の投割は、基板との密着力はもとり、トップコートとして施工する Al20・TiO2系セラミック溶射皮膜との密着性をも考慮したものである。この被覆の厚みが30μmより薄い場合は、アンダーコートとしての機能が低く、また 150μm以上厚くしても格別の効果が得られないうえ、施工に長時間を要し得策でない。

【0015】(2) トップコートの施工

- 上記アンダーコートである金属質溶射被覆を施工後、その上にトップコートとして、AlaOs・TiOs系セラミック溶射被覆を施工する。以下に、このセラミック溶射被覆について詳しく説明する。
- 【0016】さて、市販の AlzOs・TiOs 系セラミック溶射材料をプラズマ溶射して得られる被優は、これをX線回折すると、AlzOs とTiOsのピークが強く検出され、溶射材料の成分がそのまま被優成分となっている。ただし、このような結晶成分からなる被優は、上述したように、定容速度が遅く、またリーク電流が大きくなるなどの問題点があった。

【0017】そこで、発明者らは、市販の同じ ADO・TiG 系セラミック溶射材料を用い、実質的に空気(酸素)が存在しないArガス雰囲気中、もしくは多少空気が残存する雰囲気中において、とくにブラズマ作動ガスとして還元作用の強い水素ガスを用いて溶射した。この場合には、TiG の一部が酸素を放出するために、一般式Tig Oza-i (n=1~9)で表される結晶型化合物に変化することを知見した。

【0018】このように、AlzOs・TiOs系セラミック溶射材料を、水素ガスを用いてプラズマ溶射をした場合に、TiOsか酸素を放出してTio Osal (n=1~9)型化合物を生成する理由は、Ar. He, He などは、溶射熱療としてのプラズマ中ではイオンと電子に解離し、プラズマ全体としては電気的に中性であるが、局部的に電子密度の高い領域を構成する。このとき、ここをTiOs溶射粒子が通過すると酸素を放出するので、Tio Osal (n=1~9)型化合物の形に変化するものと考えられる。この現象は、溶射雰囲気中に水素が存在し、酸素がない条件下でプラズマ溶射した場合に、一層顕著に反応する。

【0019】 発明者らの実験によると、かかるTia 0 2m.t (n=1~9)型結晶化合物としては、TinOs、TizOs、TinOs TinOs T

【0020】本発明においてTioのコ (n=1~9)を含む AlzOs・TiO:系セラミック溶射被覆をトップコートとして施工するに際し、酸素を含まない大気圧以下の雰囲気中で成膜すると、熱源中を飛行する溶射粒子に対する気体の抵抗が減少するため、溶射粒子の基板への衝突ニネルギーが大きくなり、これに伴って粒子の堆積密度が大きくなり、波覆の気孔率は著しく小さくなる利点も得られるので、この方法は好産であると言える。例えば、図1は市販の85wt%AlzOs・15 wt%TiOs溶射材料を用いて得られたプラズマ溶射被覆の気孔率と溶射雰囲気圧力との関係を示したものである。この結果から例らかなように、低気圧下で形成される被覆ほど気孔率が小さくなっている。

【0021】本発明の上記トップコート溶射被療は、気 孔率3%以下のものを用いる必要があることから、この条件を満足する溶射雰囲気圧力は、図に示すところから 明らかなように、750 hPa 以下で溶射すればよいことが わかる。その理由は、気孔率3%以下のTia Ozal (n=1~9)を含む Al2Oi・TiD:系セラミック溶射被避は、体積 固有抵抗のパラツキが小さく、また高度な衰面仕上げが 可能となるなど、静電チャック用被覆として好適な特性を発揮するからである。とくに、気孔率が3%より高い 被預は、体積固有抵抗のパラツキが大きく、不良品の発生率が高くなるうえ、平滑な研修仕上げ面が得られない などの欠点がある。

【0022】本発明のセラミック溶射被覆は、平均表面 50

根さRaを 0.1~2.0 μ mの範囲に仕上げることが必要である。特に、Ra: 0.1~1.0 μ mの範囲内がより好適である。それは、Ra: 0.1 μ m未満の仕上げ面に、研磨工数が大きいため経済的でないうえ、ウエハーに対する残留吸着力が大きくなる。また、表面根さRaが2.0 μ mを超える場合は、体稅固有抵抗のバラツキが大きくなる原因となると共に、解電チャックとして使用中にあっては、シリコンウエハーの固定調差を大きくするという欠点があるので好ましくない。

【0023】本発明の目的に用いる Al: 0s - TiO: 系セラミック溶射材料中に含まれるTiO:量は、2st%~30st%、特に5st%~15st%の範囲が好適である。TiO:量が2st%より少ない場合に溶射被優の体積固有抵抗値が高すぎ、また、TiO:量が30st%より多い場合には固有抵抗値が低すぎるため、大きなリーク電流が流れるので適当でない。

【0024】なお、トップコート溶射被覆の被覆厚は50~500μmの範囲内のものがよく、特に 100~300μmの厚さを有するものが好適に使用できる。それに、50μmより薄いと、トップコートとしての機能を十分に果たすことができないだけでなく、耐電圧も低く不適である。500μmより厚い場合は施工に長時間を要することから、生産性が劣り経済的でなく、そのうえ熱調整によって剥離しやすくなる。

【0025】(3) 研磨面の射孔処理

所定の組さに研磨した、本発明にかかるTia Oza-1 (n=1) ~9)型化合物を含有する ALiOi・TiOi系セラミック溶射 被覆には、必要に応じ有機系建築化合物(市販の有機建 素樹脂)もしくは無機系珪素化合物(市販の珪素アルコ キシド化合物) を塗布したのち、120 ~350 ℃, 1時間 ~5時間加熱する。この操作は、溶射被覆中に残存して いる微細な気孔部に建築化合物を充填することにより、 異物が付着、残留することを防ぐものである。一般に、 本発明のTin Oza-1 (n=1~9)型化合物を含有する Alz Os ・TiO2系セラミック密射被覆の気孔率は3%以下と非常 に低いため、封孔処理は必須工程ではないが、静電チャ ックとして工業的に使用する際の異物の付着を防ぐ作用 もあるので、針孔処理しておく方が好ましいと言える。 本発明で使用する珪素質封孔剤として、前述の珪素アル コキシド化合物以外にポリメチルシロキサンおよびその 重合体なども用いられる。

[0026]

【実施例】 写施例 1

のである.

この実施例では、 Alz Os・TiOz 系容射材料を用いてプラ ズマ溶射した場合の雰囲気ガスの種類と原厚が及ぼす溶 射被覆中のTia Ossa (mal ~ 9)の生成状況を調査したも

(1) 供款基板: 純アルミニウム板 (寸法: 幅50mm×長さ 100mm×区8 mm)

(2) アンダーコート溶射被覆:90wt%Ni-10wt%Alを大 気中でプラズマ溶射法によって100 μm厚に施工

(3) トップコート溶射被覆: アンダーコートの上に Ala 0s -15wt%TiOz溶射材料を用いて各種の圧力およびガス 種の雰囲気下でプラズマ溶射法により300 μm厚に施工

(4) 溶射雰囲気およびその気圧:

① Arガス:30~1000 hPa

② 空気 :30~1000 hPa·

(5) プラズマ作動ガス: ArとLiの混合ガスを使用

(6) 評価方法:前配条件で施工した各種の溶射被覆は、 その断面を切断後研磨して、光学顕微鏡によって観察し 気孔率を求める一方、被覆の一部を採取しこれをX線回 折装置によってTiO:の結晶系の変化について調査した。

【0027】(7) 試験結果:この試験の結果を要約し表 1に示す。この表1に示す結果から明らかなように、A r, 空気の雰囲気とも、30~750 hPa の条件下では、被 度の気孔率が 0.4~3.0.%の範囲にあるとともに、被覆 を構成する90wt%Al20a -10 wt%TiO2中のTiO2の一部が TixOs, TixOsおよびその他のTix Oza-1 型の結晶系に変 化していることが確認された。特にAr雰囲気中30~200 hPa の条件下では (試験Io.1.2)TiO2のピークがほぼ完 全に消失し、大部分がより酸素量の少ないTic Oza-1 (n =1~9)型に変化していた。

[0028]

【去1】

	3210		C 1541, 152, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107	· · · · · ·				т-
ж.	移射探透気		現場の知识学		X	折結果		M.
	ガスの 連続	廷力 (hpa)	(94)	TiO.	7i _s O _s	Ti sūņ	Tin Dames	=
1		20	0.4~ 1.5	教出士了	٥	0	0	Ī.,
2		200	0.1~ 1.7	校出せず	0	0	О	*
3	kı	600	L5~ 21	Δ	0	0	0	8
4	Α7	153	21-10	0	ð	0	0	P
5		900	14~54	0	9	٥	0	H
6		1000	7.5~10.5	0 .	. 0	0	. o	数例
7		- 30	06-13	0	0	٥	0	
8	•	360	1.0~ 1.7	0	0	0	0	3
9	235	. 600	17~23	Ο.	0	0	0	•
10		750	25-3.0	ο	8	0	0.	91
п	•	000	4.0~ 6.8.	ð		_	. Д	H
12	<u>'</u>	1000	8.5~13.0	6	_	_	Δ	較例

の:亜鉛製新ピーク

【0029】実施例2

この実施例では、実施例1の被覆を用いて研磨仕上げの 限界を求めるとともに、熱衝撃試験を行い、被覆の密着 性と熱衝撃による被覆の機械的抵抗性を調査した。

(1) 供試基板: 実施例1に同じ

(2) アンダーコート容射被覆: 実施例1に同じ

(3) トップコート溶射被覆: 実施例1に同じ

(4) 溶射雰囲気およびその気圧:

Arガス: 60, 200, 750, 900, 1000 hPa

(5) プラズマ作動ガス: 実施例1に同じ

(6) 評価方法:上記の要領で作製した被覆を研修して、 可能な限り強面に仕上げた後、大気中で 300℃×10分間 加熱した後これを放冷して室道まで冷却する操作を10回 操返し、被覆の外観変化(平均組さRa)を調査した。な お、この試験には、珪素アルコキンド化合物を3回塗布 役 200℃×30分の乾燥処理を施した被覆についてもその 効果を調べた。

【0030】(7) 試験結果:この試験の結果を表2に示 した。表2に示すとおり、低圧力(60~750hpa)で溶射 成膜したものほど気孔率が小さくかつ研磨仕上げ面が平 滑である。ただし、溶射雰囲気の圧力が 900hpa, 1000h paで得られる被覆では、平滑な研磨面は得られない結果 となった。この原因は、低圧力 (30~750 hpa)で形成さ れる被覆は、気孔率が低いため研磨面はRa: 0.1 ~2.5 μmの範囲に収まるが、気孔率の高い被覆(900~1000hp a)では、気孔部がピット状となって舞出するため、表面 粗さは必然的に大きくなったものと考えられる。一方、 これらの被覆の熱衝撃抵抗は封孔剤の有無にかかわら ず、本試験条件下では比較的良好な性能を発揮した。お ずかに、封孔剤のない被覆(No.4,5)のみに、8回の繰

(7)

特開平9-69554

返し試験技に微少な割れの発生が認められたのみであっ た。以上の結果から、本発明の被覆は観路であるため、 平滑な研磨が可能であるうえ、本実施例の条件では對孔 剤の有無にかかわらず良好な耐熱衝撃抵抗性を有してい

ることが確認された。 [0031] 【表 2】

_					r	1
No.	法針罗因气	皮膚	の 生状	の観点引は	Market Special	
_	医力 (kpe)	. (96) . (96)	銀版服さ 1a (ps)	*#	TOTAL STATE OF THE	*
1	60;	0.5~15	a 1~ 03		10日まで高ななし	
2	200	& \$~ 1.7	0.3~0.5]	10回主で美電なし	本具現
3	750	2 (- 2.0	Q 8- 25	無	10回をで書金なし	15"
4	90C	11-51	12-15]	8回で配かる作業生	H
5	1990	7, 5~10, 5	12- (1]	8回で数小部九発生	例
6	60	£5~ £5	Q 1 0:3		10回なで異常なし	
7	200	0.8~17	03-05].	が励まて資金なし	本発
8	750	24~ 20.	01-25	*	10回まで異常なし	明
9	900	18-51	12-15	1	10回せで異常なし	H
10	1000	7.5~10.5	12~11		10回まで異念なし	8

- (勝本) (1) ブラズマガスとしておノ1,及合ガスを使用 (2) 皮薬の転換型は変 | と同じ (3) 皮薬の転換型性変 | 200℃×imin 21五星の標底し 18 回

【0032】実施例3

本発明にかかる AlzO:・TiO:系セラミック溶射被覆の 休積四有抵抗を測定し、そのパラツキを従来の容射法に よって得られた被覆と比較した。

- (1) 供試基板: 実施例1に同じ
- (2) アンダーコート溶射被覆: 実施例1に同じ
- (3) トップコート溶射被覆: Al20s -15wt%TiOz材料を 用いて各種の圧力およびガス種の雰囲気下でプラズマ溶 30 射法によって 250 µm と500 µm厚に施工
- (4) 溶射雰囲気およびその気圧
- ① Arガス 60, 750, 1000 hPa
- ② 空気 60, 750, 1000 hPa
- (5) プラズマ作動ガス: なと貼の混合ガスを使用

溶射被覆の表面にドータイトを適布してこれを電極と し、基板のアルミニウムとの間に直流 500 V を印加した ときの抵抗値から、次の式を用いて体積固有抵抗率を測 定した。

体積固有抵抗率ρ=RA/d (Q·cm)

A:電極面積(cm²) d:皮膜厚さ(cm)

R:抵抗值(Q)

測定は、供試被覆一枚当たり5個所とするとともに、珪 素アルコキシド化合物(塗布後 200℃×30分乾燥、3回 繰返し)封孔処理の効果についても調査した。

【0033】(7) 試験結果

測定結果を表3に示した。表3に示す結果から明らかな ように、比較例の溶射雰囲気1000hPa 下で成膜した被覆 (No.5, 6, 11, 12)は、Ar, 空気中とも体積固有抵抗の バラツキが大きく、封孔処理の効果もあまり明確でなか った。これに対し、本発明の被覆(Bo.1~4, 7~10) は、気孔率が小さく、緻密な性状を有するとともに、溶 射材料中のTiO:の一部がTio Oza-i (nel~9)に変化して いるため、測定値のパラツキが少なく、本発明の静電チ ャックが必要とする体積固有抵抗値: 1×10°~10¹¹Ω ·cmの範囲にあり、品質管理が極めて容易であることが 確認された。

[0034]

【表3】

13

ъ	15A13	文色区		溶量皮质.0. 连块				
_	がスの 頂荷	迁力 (leps)	医 厚 (μs)	知凡本 (%)	Tin Cro-s CONTE	対孔の 有無	体験要存成的性 (ロ・ロ*)	
1		€ 3	250	0.5~ 1.5	#	#	1 ×10'*~10''	
2		50	503	0.5~ 1.4	, #F	無	1×10,4-10,1	
3		750	250	24~ 10	市	#	1×10° ~10''	A
4	Ar	750	500	2.2~ 2.1	存	無	1×10° ~10''	*
5		1000	250	7.5-10.5	1	Ŧ	1 × 10' ~10''	H
6		1090	501	7.2~10.8	*	舞	1 ×10' -10''	8
7		60	250	0.5~ 1.6	相	ŧ	1×10**~10**	
8	•	60	503	0.5~ L.5	右	No.	1×10'*~10''	
9		750	. 258	2.3~ 2.0	₩	#	1×10" ~10"	4
פנ	蛱	750.	590	2.4~ 3.0	*	N2	I ×10° ~10°	99
Ľ		- 1000	250	7.6~11.5	年	4	1 ×10" ~10"	世
12	i	1000	500	7.9~12.0	A	JE.	1×10* ~1013	較明

(自美) (1) Ti, N₁₀₋₁ の内保は、Ti,D₁₀ Ti,D₁₀ その他のTi, D₂₀₋₁ (四十つ) (2) 斜孔処理)は発アルコキシド化合物療育後 209で×30分数基本 3 回路返し処理

【0035】実施例4

本発明にかかる Ala O:・TiO:系ゼラミック溶射被覆を施 工した静電チャックの、シリコンウエハーの吸着力およ び残留吸着力の減衰速度を測定した。

(i) 辞租チャック基板: 厚さ40mm、直径200 mmの円板状のアルミ合金製の基板とし、これをアルミナでブラストした後、90wt%N1-10wt%A1をアンダーコートとして 1 00μm呼に大気プラズマ密射法によって施工した。その後、このアングーコートの上に実施例1の要例で AL: 0n 50 - 8wt%T10: 被限を300μm 呼に施工した。その後、ポリメテル・シクロキサン重合体を登布後、250℃×1時間の対孔処理を行ったものも供試した。なお、比較例として、AL: 0n - 8 wt%Ti0: を大気中で 300μm 呼に施工したものを試験した。

(2) 計価方法:図2は、本発明の溶射被覆を用いてシリコンケエハの吸着力と残留吸着力の被衰速度を測定する 装置の概要を示したものである。この装置は、真空容器 1の中に、アルミ合金製の静電チャック基板2を介し、 その中央部に溶射被覆3を固着し、そしてこの溶射被覆40 3の上にシリコンウエハ4を静置して構成されている。 また、静重チャック基板2には、冷却用の冷煤を流す空 孔5が設けられているとともに、真空容器1外に設けら れている電源6に接続されている。また、シリコンウエ ハには、アース線7が取付けられ、静電チャック上部に は絶縁用セラミックス8が配設されている。

【0036】(3) 試験結果:設圧印加時のシリコンウェハに対する静電吸着力と印加度圧切断後の残留吸着力の減衰状況を表4に示す。この表4に示す結果から明らかなように、比較例の溶射被覆の吸着力は、印加電圧250 Vで24~30 gf/cm²;500 Vで30~150 gf/cm² 程度であるのに対し、本発明の溶射被覆は前者の条件で100 gf/cm² 前後、後者の条件で300~350 gf/cm² に違する吸着力を示した。また、吸着力減衰速度は、比較例の溶射被覆が電圧切断60秒後でも3~10gf/cm²の残留が認められるのに対し、本発明の溶射被程は電流切断1秒以内に完全に吸着力が消失していた。

【0037】

15

in.	ID# 1	51254 	数数中の Fig Grant	封孔机理	参写成者力 (gi/cm²)		共和 . (以)	摊	
	がスの	圧 カ (kpe)	0 i ii	の有難	250 7	500 1	186	 	*
1		- 1	#	·#	95123	300550		-	T
2		×	*	93~106	306-345	0	-	1_	
3).	637	* *	*	95LD2	300~348	0	-	*
4			শ)E	97~106	304~350	. 0	-	舞
5			有	45	96~i02	302~345	8	-	リリ
6		60	¥	NE.	95-101	395-335	0	-	7
7	S. S.		有	哲	9 6~ 100	310~330	.0	-	İ
8		750	4	TR	92~100	302~331	0	-	
Ð			, Mi	#	5~1	25~ 30	5~23	3~10	比
10	25	1085	5	ALT .	5-1	2425	4~24	4-8	数例

(明考)

- (i) It. 0.... の内配は、Ti.O.、Ti.O.、その他のTi. 0.... (年) かで表示できる
- (2) 封孔紅珠辻、ボリメテル・シロトサン製合体を全有後 200℃×1 時間加熱

【0038】実施例5

この実施例では、アンダーユート溶射被覆の有無による本発明にかかるAlzO:・TiOz系セラミック溶射被覆の密・着性について調査した。

- (1) 供試基板:市販のA1、Mo、W材料を幅50mm×長さ 1 00mm×厚さ8mmに切断したものを基板とした。
- (2) アンダーコート被覆:実施例1と同じ容射材料を用い、大気中でプラズマ溶射法によって基板上に30μm.
- 100 µm, 150 µm厚に施工した。
- (3) トップコート被視: 実施例1の容射材料を用い、60 hpsのAr中で、水染ガスとArガスの混合プラズマフレー 50 Aを用い、300 μm厚に施工した。なお、比較例として、上配アンダーコート被覆を施工せず、基板上に直接トップコート溶射被覆を 300μm厚に処理した試験片を作製して試験した。
- (4) 評価方法:上記のようにして作製した被覆試験片を 用いて、大気中で 300℃×10分間の加熱を行った後、こ れに筆温の空気を吹付けて冷却する操作を1サイクルと して10回繰返し、トップコート溶射被覆の割れや剥離の 有無を調べた。

【0039】(5) 試験結果:試験結果を表5に要約した。この結果から明らかなように、アンダーコート溶射被硬のないトップコート溶射被硬 (Ho.10. H. 12)は、系板材料の種類に関係なく2~3回の熱衝撃試験の繰返しによって割れが発生するとともに、被硬の30~50%が刺離した。これに対し、本発明にかかるアンダーコート溶射被腰を有するトップコート溶射被腰(No.1~9)は、基板材料の種類に関係なく良好な充着性を示し、10回の熱衝撃試験の繰返しにおいても全く異常は認められなかった。

[0040]

20 【表5

13	長5]				τ-
Ga.	200 ALTH	カナナト製造庫	トゥカート製房運	克斯學以數 位果	1
_		(µm)	(µm)		*
1		30	300	10回まで美帯なし	
2	Al·	100	300	的四まで共命なし]_
3		150	100	14円まで異常なし	*
4		3-)	300	公司まで異常なし	
í	M+	100	300	加盟まで異常なし	9
6		150	300	10回まで異常なし	۳.
9		30	360	10回せて異念なし	
8	w	100	300	10回食で異念なし	
8		150	300	10回まで異常なし	_
10	Al	αι	300	2回で1400	
11	Шo	άL.	700	3 D C 200	比較例
12	W	在し	30	3 ED 17 1895	1"

(勝等) (1) アンブーコート被機材料は、50mt K Ej = 10 mt K Al (2) トップコート被威材料は、AlaG, - 15 mt K TiO₂

[0041]

【発明の効果】上述した説明ならびに実施例の結果から明らかなように、本発明の、Al:O: と共存するTiO:の一部もしくはその全部をTin O:n-1 (n=1~9)の一般式で表される結晶型化合物に変化したセラミック溶射被視は、シリコンウエハー等の吸着力が強く、一方で残留仮着力の減衰速度が速く、静電チャックとしての基本的な特性に極めて優れている。しかも、アンダーコート、トップコートとも基板や下層との密着性や観音度も優れ、品質が安定している。また、体積固有抵抗率のパラツキが小さいので、品質管理が容易で生産性が高いなどの特徴が

(10)

特開平9-69554

あり、静電チャックを使用する産業分野の発展に大きぐ 貢献する,

【図面の簡単な説明】

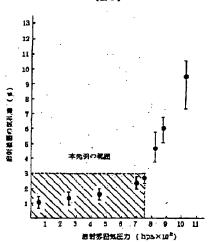
【図1】 A1203 · TiO1系密射材料を用いてプラズマ溶射 した際の雰囲気圧力と得られた狭覆の気孔率の関係を示 したグラフ。

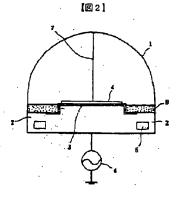
【図2】プラズマ浴外法によって施工した Al:Os・TiOs 系被積形成静電チャックの体積抵抗率測定装置の概要図 である。

【符号の説明】

- 1 真空容器
- 2 静電チャック基板
- 3 溶射被腦
- 4 シリコンウエハ 3
- 5. 冷媒を流す空孔
- 6·交流電源
- 7 アース線
- 8 絶縁用セラミックス

[図1]





フロントページの続き

(51) Int.C1.		識別記号	庁內整理番号	FΙ			技術表示箇所
H01L	21/3065			H02N	13/00	D	•
H02N	13/00			H01L	21/203	z	
// H01L	21/203				21/302	В	